

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
Томский государственный  
университет систем управления и  
радиоэлектроники.

Председателю диссертационного  
совета 212.268.04 на базе Томского  
государственного университета  
систем управления и  
радиоэлектроники, д.т.н., профессору  
Шандарову С.М.

Я, Егоркин Владимир Ильич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник кафедры квантовой физики и наноэлектроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», согласен быть официальным оппонентом диссертационной работы диссертацию Великовского Леонида Эдуардовича «СВЧ транзистор миллиметрового диапазона на основе (InAlGa)N/AlN/GaN гетероструктуры с легированными буферными слоями» по специальности 01.04.04 – «физическая электроника», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.04.

О себе сообщаю следующие данные:

Кандидат технических наук по специальности 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро - и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Согласен на обработку персональных данных.

к.т.н., ведущий научный  
сотрудник кафедры квантовой  
физики и наноэлектроники  
НИУ МИЭТ

Подпись Егоркина В.И. удостоверяю

Начальник ОК МИЭТ



/ Егоркин Владимир Ильич/

Заболотный С. В.

Список основных публикаций Егоркина Владимира Ильича, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника кафедры квантовой физики и нанoeлектроники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», официального оппонента по диссертации Великовского Л.Э. «СВЧ транзистор миллиметрового диапазона на основе (InAlGa)N/AlN/GaN гетероструктуры с легированными буферными слоями», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.04 «Физическая электроника».


1. DETECTION OF TERAHERTZ RADIATION BY TIGHTLY CONCATENATED INGAAS FIELD-EFFECT TRANSISTORS INTEGRATED ON A SINGLE CHIP Popov V.V., Yermolaev D.M., Shapoval S.Yu., Maremyanin K.V., Gavrilenko V.I., Zemlyakov V.E., Bepalov V.A., Yegorkin V.I., Maleev N.A., Ustinov V.M. Applied Physics Letters. 2014. Т. 104. № 16. С. 163508.
2. DETECTION OF TERAHERTZ RADIATION BY DENSE ARRAYS OF INGAAS TRANSISTORS Yermolayev D.M., Polushkin E.A., Shapoval S.Y., Popov V.V., Marem'yanin K.V., Gavrilenko V.I., Maleev N.A., Ustinov V.M., Zemlyakov V.E., Yegorkin V.I., Bepalov V.A., Muravjov A.V., Rummyantsev S.L., Shur M.S. International Journal of High Speed Electronics and Systems. 2015. Т. 24. № 1-2. С. 1550002.
3. 3-D PROPERTIES OF THE SWITCHING TRANSIENT IN A HIGH-SPEED AVALANCHE TRANSISTOR REQUIRE OPTIMAL CHIP DESIGN Duan G., Vainshtein S.N., Kostamovaara J.T., Zemlyakov V.E., Egorkin V.I. IEEE Transactions on Electron Devices. 2014. Т. 61. № 3. С. 716-721.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В GAN И GAAS СТРУКТУРАХ ПОСЛЕ ГАММА-НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ Тарасова Е.А., Хананова А.В., Оболенский С.В., Земляков В.Е., Свешников Ю.Н., Егоркин В.И., Иванов В.А., Медведев Г.В., Смотрин Д.С. Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50. № 3. С. 331-338
5. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАМ НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ Неженцев А.В., Земляков В.Е., Гармаш В.И., Егоркин В.И. Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2016. Т. 2. № 1. С. 193-199
6. A STUDY OF THE EFFECT OF THE STRUCTURE OF PLASMA-CHEMICAL SILICON NITRIDE ON ITS MASKING PROPERTIES Garmash V.I., Egorkin V.I., Zemlyakov V.E., Kovalchuk A.V., Shapoval S.Y. Semiconductors. 2015. Т. 49. № 13. С. 1727-1730

7. NORMALLY OFF TRANSISTORS BASED ON IN SITU PASSIVATED ALN/GAN HETEROSTRUCTURES Zhuravlev K.S., Malin T.V., Mansurov V.G., Zemlyakov V.E., Egorkin V.I., Parnes Y.M. Technical Physics Letters. 2016. T. 42. № 7. С. 750-753
8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИС МАЛОШУМЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ СВЧ-ДИАПАЗОНА Иовдальский В.А., Виноградов В.Г., Манченко Л.В., Земляков В.Е., Лапин В.Г. Электронная техника. Серия 1: СВЧ-техника. 2015. № 4 (527). С. 85-90
9. OPTIMIZATION OF OHMIC CONTACTS TO N-GAAS LAYERS OF HETEROBIPOLAR NANOHETEROSTRUCTURES Egorkin V.I., Zemlyakov V.E., Nezhentsev A.V., Garmash V.I. Russian Microelectronics. 2017. T. 46. № 4. С. 272-276
10. INTERFEROMETRICALLY ENHANCED SUB-TERAHERTZ PICOSECOND IMAGING UTILIZING A MINIATURE COLLAPSING-FIELD-DOMAIN SOURCE Vainshtein S.N., Duan G., Mikhnev V.A., Kostamovaara J.T., Zemlyakov V.E., Egorkin V.I., Kalyuzhnyy N.A., Maleev N.A., Näpänkangas J., Sequeiros R.B. Applied Physics Letters. 2018. T. 112. № 19. С. 191104

к.т.н., ведущий научный  
сотрудник кафедры квантовой  
физики и наноэлектроники  
НИУ МИЭТ

Подпись Егоркина В.И. удостоверяю  
Начальник ОК МИЭТ



  
/ Егоркин Владимир Ильич /

  
Заболотный С. В.